

HWE-Skript

Leopold Götsch

2023-11-27

Inhaltsverzeichnis

Willkommen zum Skript	3
Verbessern	3
Mitwirken	3
I. 4. Jahrgang	4
1. Die Projekte	5
1.1. Leistungsverstärker	5
1.1.1. Die Gegentaktendstufe	5
1.1.2. Rückkopplung	9
1.1.3. Vorspannen	9
1.1.4. Reale Spannungsquelle	15
1.1.5. Stromversorgung	15
1.1.6. Reale Stromquelle	15
1.1.7. Praktische Herangehensweise	15
References	17

Willkommen zum Skript

In Arbeit!!

Dieses Skriptum dient zu Unterstützung und Ergänzung der Inhalte aus dem Unterricht. Der “rote Faden” im Unterricht ist in den jeweiligen Klassennotizbüchern zu finden. Darin sind auch Links zu den passenden Kapiteln in diesem Skript zu finden. Das Skriptum wird ständig erweitert und verbessert. Input ist willkommen.

Verbessern

Ich freue mich über alle Fehlerkorrekturen und Verbesserungsvorschläge die mich erreichen. Am einfachsten ist dies via Mail.

Mitwirken

Wer am Skriptum mitarbeiten möchte kann mich gerne kontaktieren. Meine Kontaktdaten sind auf der Homepage der HTL-Anichstrasse zu finden.

Viel Vergnügen mit HWE und dem interaktiven Quarto Book!

Teil I.

4. Jahrgang

1. Die Projekte

1.1. Leistungsverstärker

Transistorverstärker wie Sie bisher bekannt sind **sec-BJT**, in denen ein Transistor in einem Arbeitspunkt betrieben wird, haben bei höheren Leistungen eine zu hohe Verlustleistung. Die Verlustleistung ist proportional zum Strom durch den Kollektor I_C in Ruhe, also ohne Signal am Eingang. Bei der Emitterschaltung ist der Ruhestrom höher da der Arbeitspunkt auf der Kennlinie weiter “oben” ist. Diese Betriebsart wird auch A - Betrieb genannt.

Um höhere Leistungen und eine geringere Verlustleistung zu erreichen muss der Arbeitspunkt nach “unten” also zu einem kleineren I_C gebracht werden. Wird dies am Beispiel des Verstärkers in Emittergrundschaltung **sec-BJT** gemacht würde das bedeuten, dass nur noch eine Halbwelle verstärkt wird. Um dies zu verhindern werden ein PNP und ein NPN Transistor in Gegentakt geschaltet. Jeder Transistor übernimmt nun die Verstärkung einer Halbwelle. Warum der I_C , und damit die Verlustleistung, trotzdem nicht ganz Null sein kann, sehen wir im folgenden Teil.

1.1.1. Die Gegentaktendstufe

Um zu vermeiden, dass der Arbeitspunkt eine höhere Verlustleistung aufgrund eines höheren I_C verursacht, und trotzdem ein symmetrisches Signal verstärkt werden kann, können zwei Transistoren eingesetzt werden. Damit ist auch die maximale Leistung höher, da der Arbeitsbereich pro Transistor besser ausgenutzt wird. Ein Transistor verstärkt die positiven Signale. Der andere die negativen. Dies wird Gegentaktendstufe genannt und die Betriebsart wird als B bezeichnet. Wird eine reale Schaltung entwickelt ist stets darauf zu achten, dass die Bauteileigenschaften berücksichtigt werden. Speziell die Maximalwerte dürfen nicht überschritten werden.

Wir diese Schaltung einem Test unterzogen zeigt sich, dass das Ergebnis wenig zufriedenstellend ist. Weder wird die Amplitude erreicht, das Signal wird gedämpft, noch folgt der Ausgang dem sinusförmigen Verlauf des Eingangs. Speziell an den Nulldurchgängen gibt es beträchtliche Verzerrungen. Als Qualitätskriterium soll von nun an die Differenz zwischen Ausgangsspannung und Eingangsspannung herangezogen werden.

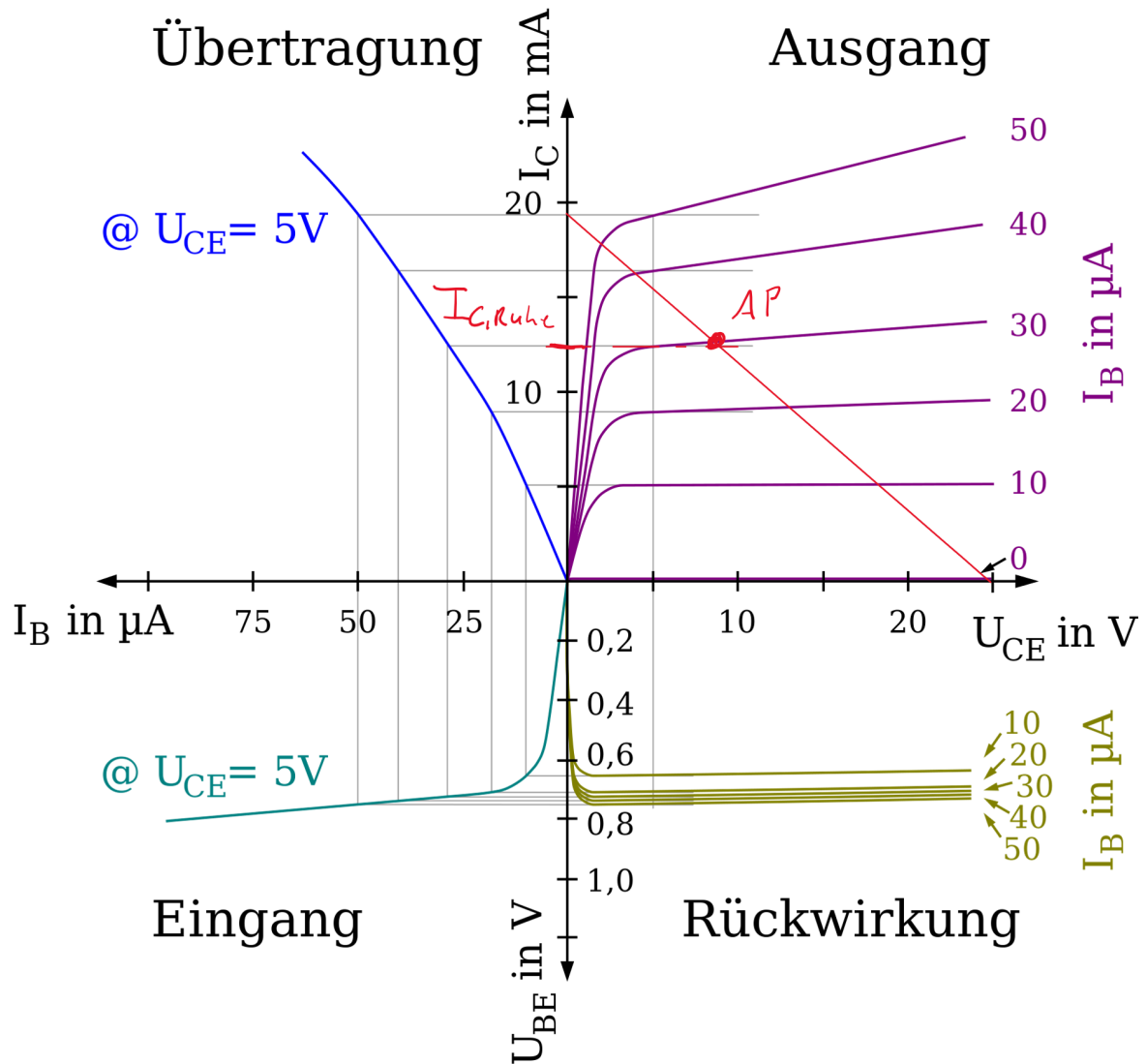


Abbildung 1.1.: Bipolartransistor Arbeitspunkt und Ruhestrom [1]

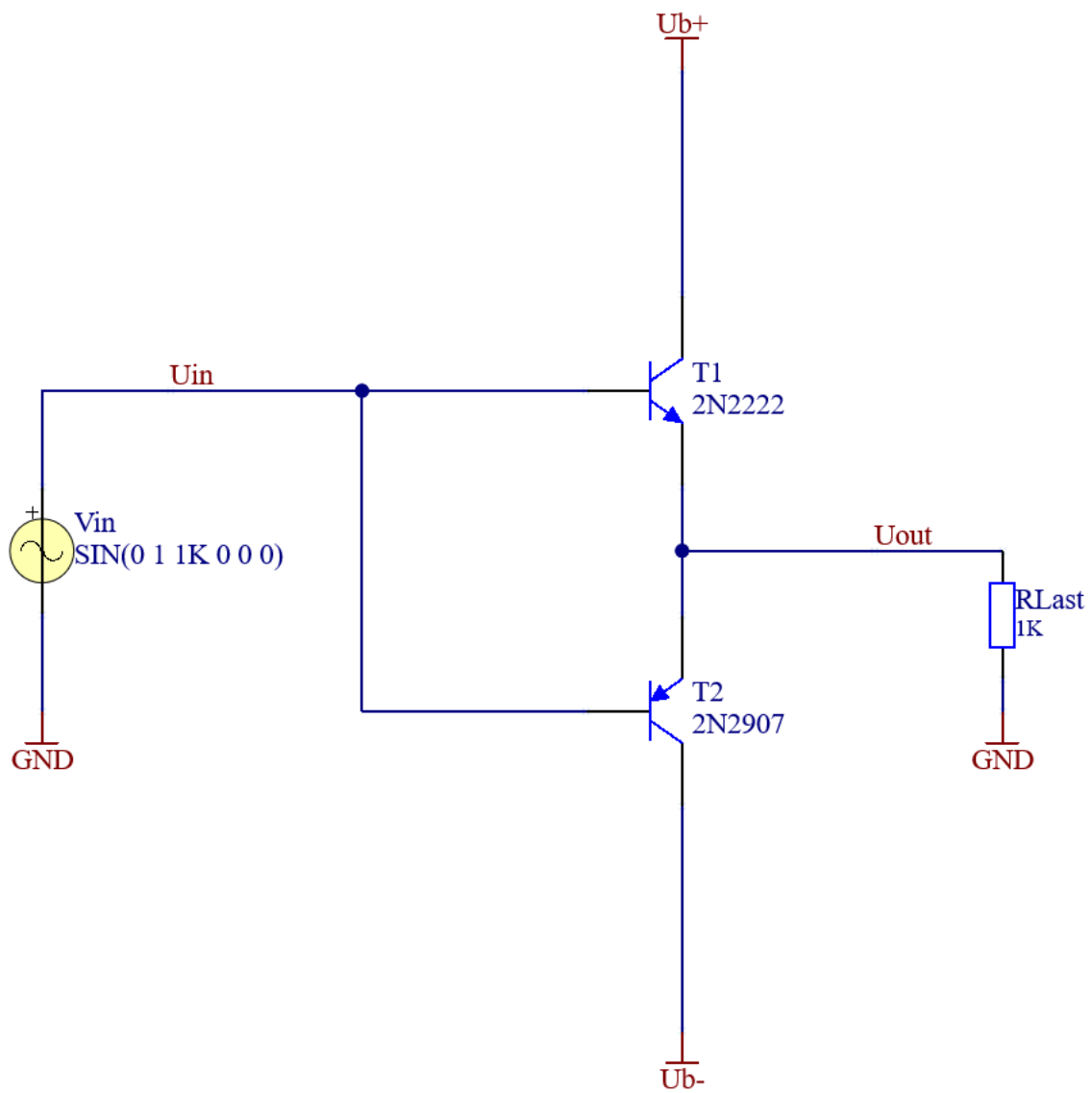


Abbildung 1.2.: Bipolartransistoren in Gegentakt

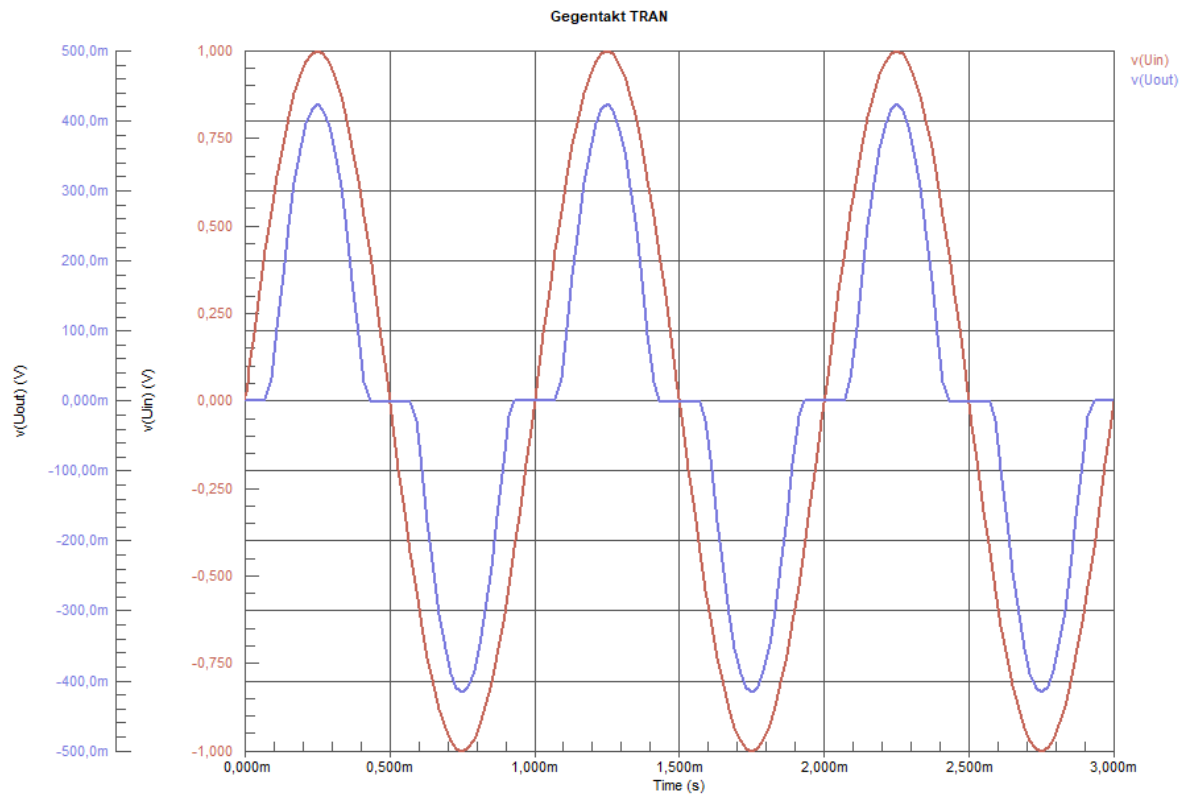


Abbildung 1.3.: Bipolartransistoren in Gegentakt, Simulationsergebnisse

Simulationsparameter	Wert	Bemerkung
Vin Frequenz	1 kHz	
Vin Amplitude	1 V	
Simulierte Perioden	3	

1.1.2. Rückkopplung

Um die den Verlauf der Ausgangsspannung an den Verlauf der Eingangsspannung anzupassen wird eine Gegenkopplung verwendet. Dazu ist eine Subtraktion des Ausgangssignals vom Eingangssignal notwendig. Als Transistorschaltung würde sich eine Differenzverstärkerschaltung anbieten. Für ein noch besseres Ergebnis wird hier ein OPV eingesetzt. Durch die Rückkopplung der gesamten Ausgangsspannung wird eine Spannungsverstärkung von Eins erreicht. Das Ausgangssignal folgt dem Eingangssignal. Eine legitime Frage ist, warum nicht einfach nur der OPV verwendet wird? Hier kann auf die Überschrift verwiesen werden. Es soll Leistung verstärkt werden. Und die Ausgangsleistung eines OPV reicht in der Regel nicht aus um beispielsweise Lautsprecher zu betreiben.

Mittels Simulation kann nun erneut die Qualität überprüft werden. Es ist zu erkennen, dass die Amplitude erreicht wird. An den Nulldurchgängen sind jedoch noch Störungen zu sehen. Die Ursache dieser Störungen sind die Kennlinien der Transistoren. In [Abbildung 1.1](#) lässt sich Erkennen, dass sich in der Nähe des Ursprunges ein Knick befindet. Erst ab einer U_{BE} größer von ca. 0,7 V beginnt der Transistor zu leiten. Das bedeutet, dass Eingangssignale kleiner als diese minimal notwendige Basis- Emitterspannung nicht verstärkt werden.

Der OPV wirkt zwar auch den Übergabeverzerrungen entgegen, allerdings stark abhängig von der Frequenz. Je schneller im Verhältnis zum Signal der OPV sein Ausgangssignal ändern kann ums kleiner sind die Verzerrungen. Wie schnell der OPV seinen Ausgang ändern kann hängt von der Slew-Rate mit der Einheit $\frac{V}{s}$ ab.

Simulationsparameter	Wert	Bemerkung
Vin Frequenz	10 kHz	
Vin Amplitude	1 V	
Simulierte Perioden	3	

1.1.3. Vorspannen

Um die Übergabeverzerrungen zu eliminieren wird die B-E Strecke vorgespannt. Das bedeutet eine Spannung anzulegen welche größer ist als die Schwellspannung der Basis- Emitter Strecke. Damit ist der Transistor bereits im leitenden Bereich und wird nur noch vom Eingangssignal weiter angesteuert.

Da durch das Vorspannen auch ein Kollektorstrom durch den Transistor fließt wenn am

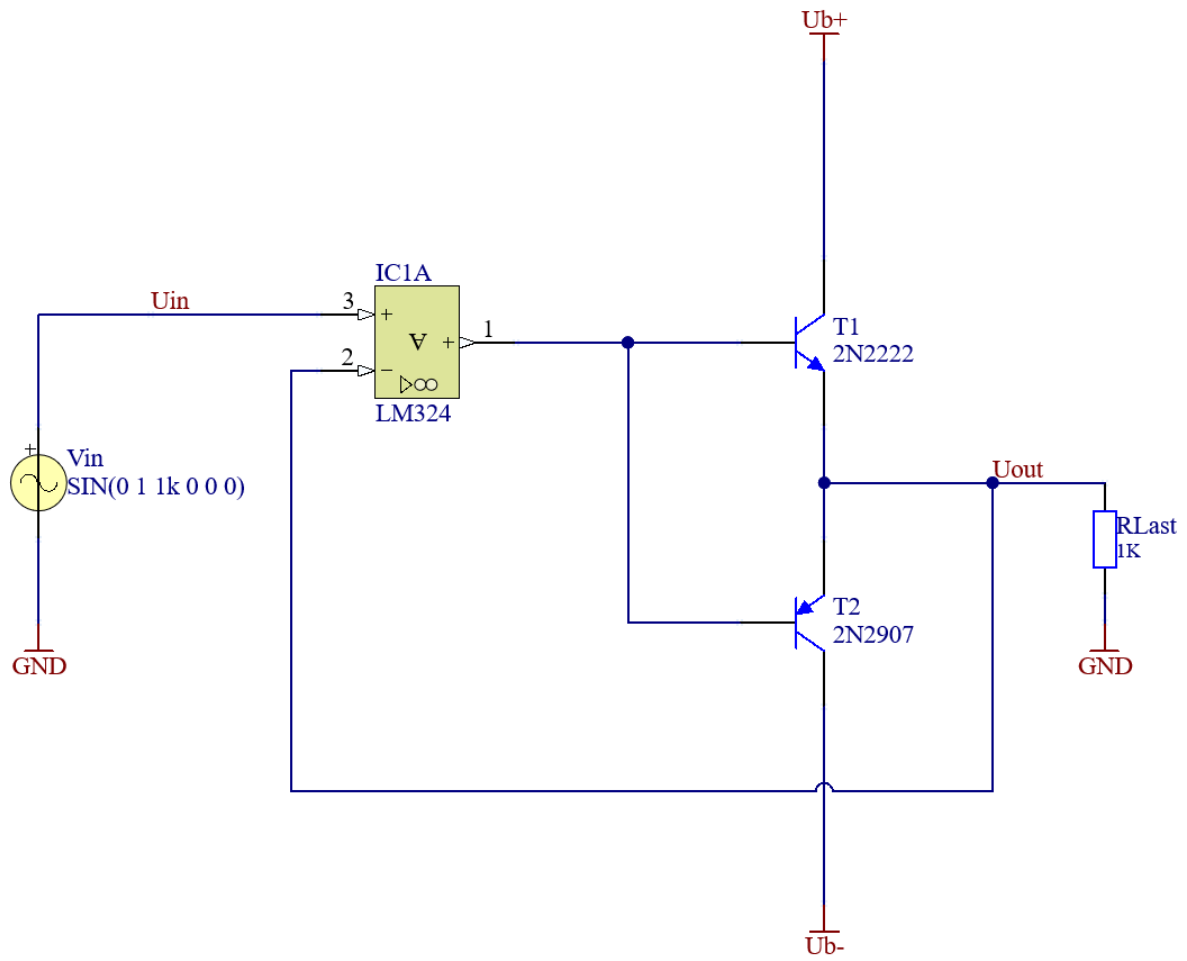


Abbildung 1.4.: Gegentaktendstufe mit Rückkopplung

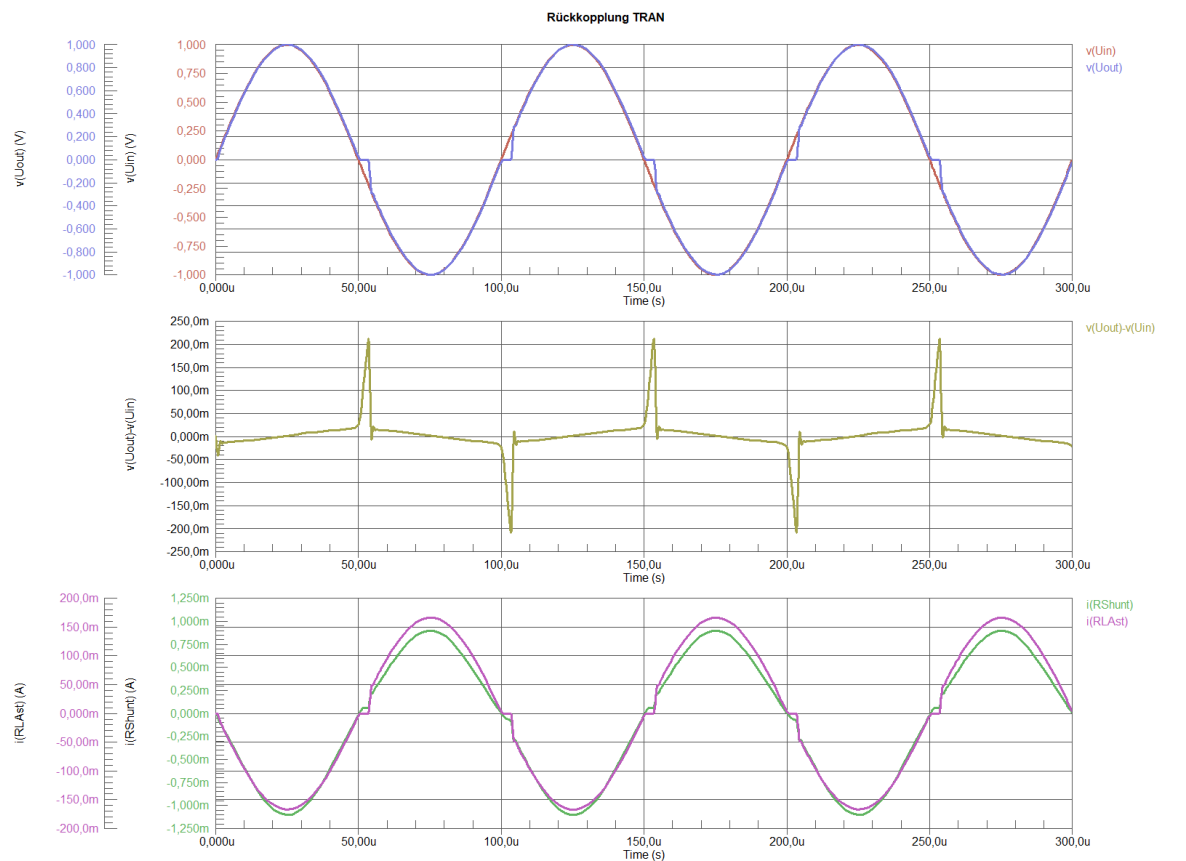


Abbildung 1.5.: Gegentaktendstufe mit Rückkopplung, Simulationsergebnisse

Eingang 0 V anliegen erhöhen sich die Verluste. Dieser Kollektorstrom wird auch als Ruhestrom bezeichnet $I_{C,Ruhe}$. Um den Ruhestrom möglichst klein zu halten muss die Spannungsquelle an die Transistoren und deren Fertigungstoleranzen angepasst werden.

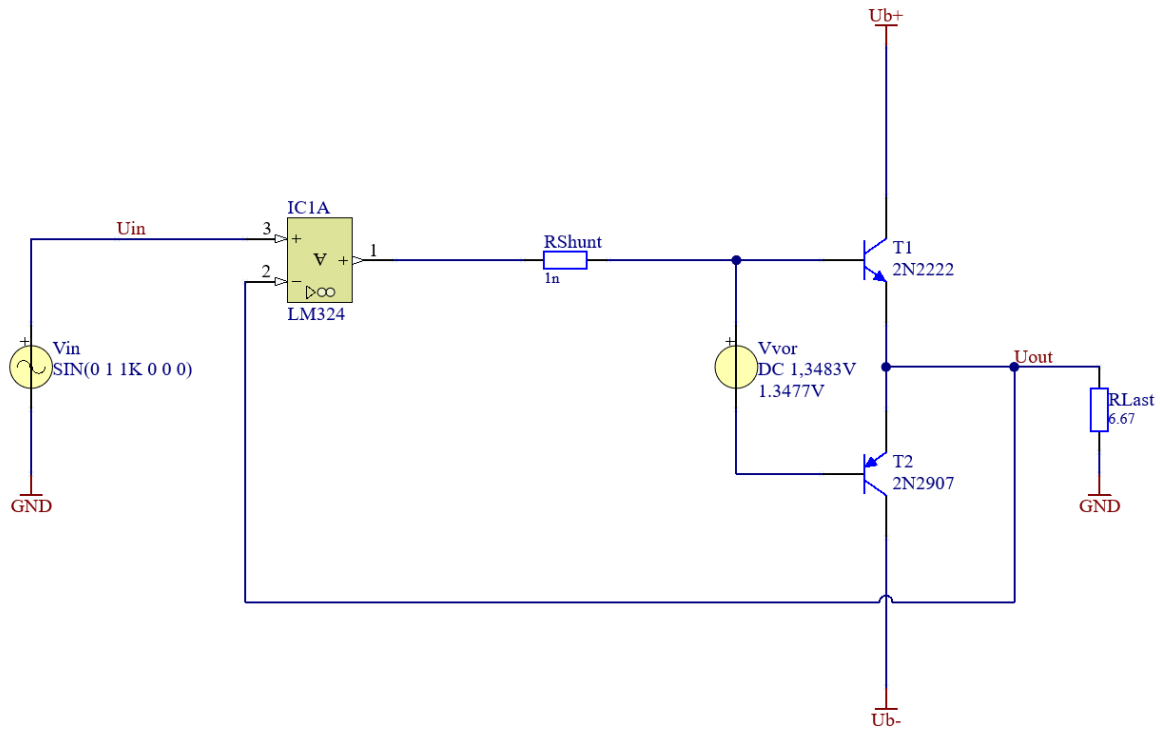
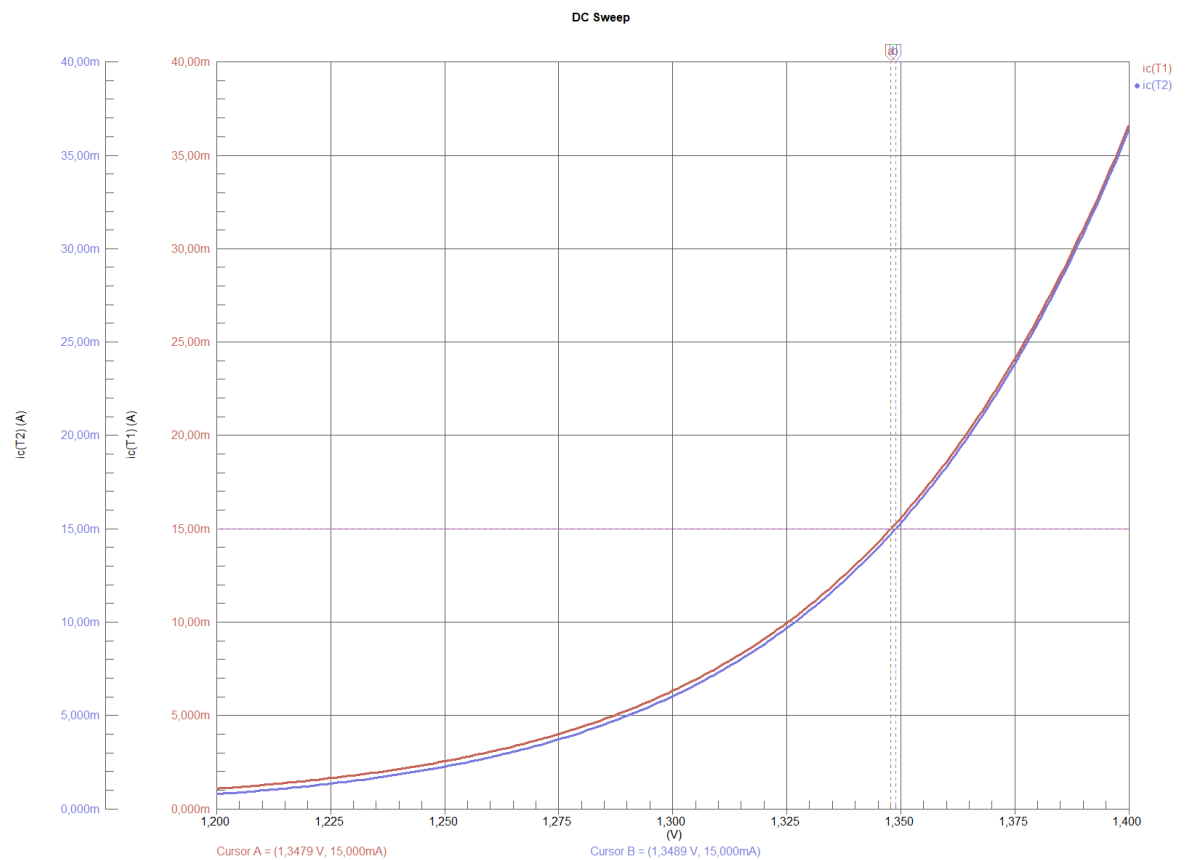


Abbildung 1.6.: Gegentaktendstufe mit vorgespannten Transistoren

Mittels DC-Sweep kann die Spannungsquelle auf einen gewünschten I_C eingestellt werden. Der I_C ist so zu wählen, dass der Arbeitspunkt außerhalb des nichtlinearen Bereichs der Transistorkennlinie liegt ist. Gleichzeitig soll er so klein als Möglich sein um die Verluste gering zu halten. Hier soll der I_C soll ein Zehntel des maximalen Laststromes betragen.



Simulationsparameter	Wert	Bemerkung
Vvor min	1,2 V	
Vvor max	1,4 V	
Vvor step size	1 mV	

Mit dem Cursor können die Ergebnisse exakt abgelesen werden.

Simulationsergebnis	Wert	Bemerkung
Vvor bei $I_C = 15 \text{ mA}$ an T1	1,3479 V	
Vvor bei $I_C = 15 \text{ mA}$ an T2	1,3489 V	

Da es sich um unterschiedliche Transistoren handelt ist natürlich auch der Zusammenhang zwischen U_{BE} und I_C ein anderes. Da die Werte sehr nahe beieinander liegen kann ein gerundetes arithmetisches Mittel als Ergebnis für V_{Vor} verwendet werden.

Der Verstärker hat nun eine Qualität, welche das Verstärken von niederfrequenten Signalen in ausreichender Güte erlaubt um Beispielsweise Musik zu verstärken. Dies ist am geringen Unterschied zwischen der Eingangsspannung und Ausgangsspannung zu erkennen.

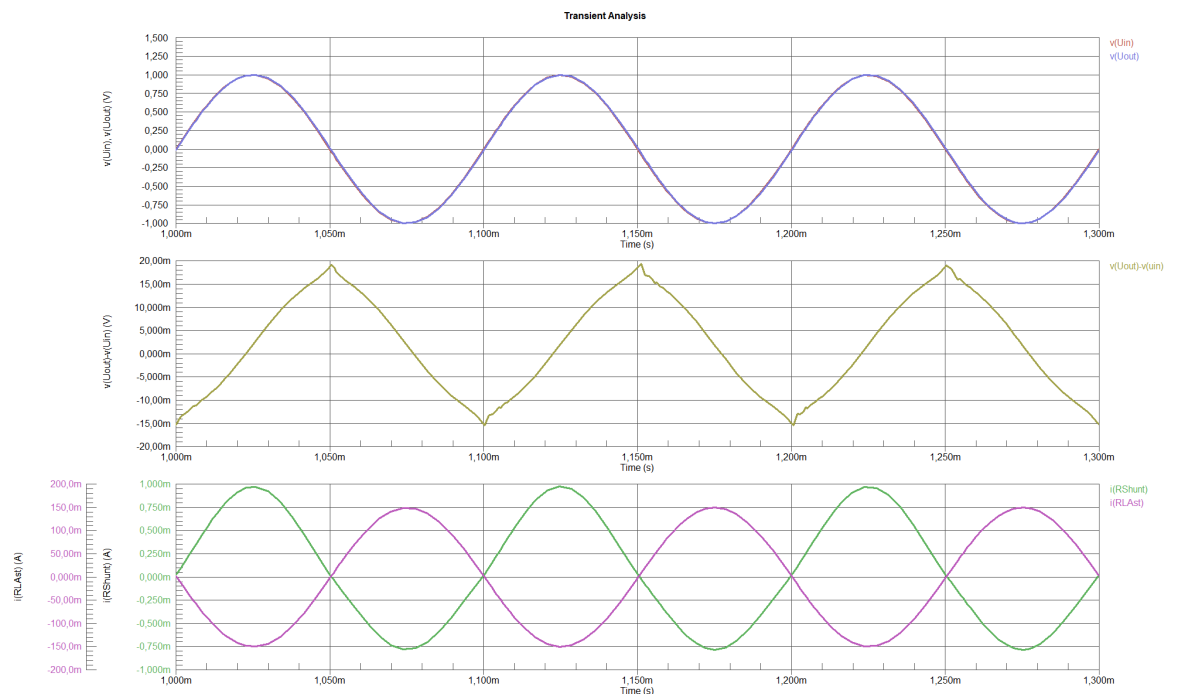


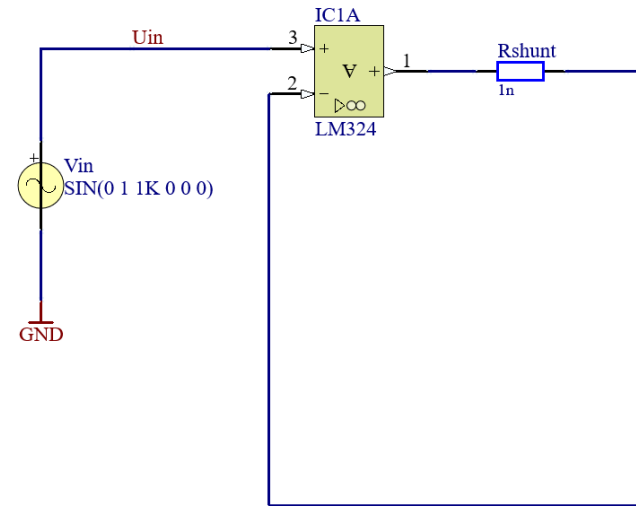
Abbildung 1.7.: Gegentaktendstufe mit vorgespannten Transistoren, Simulationsergebnisse

Simulationsparameter	Wert	Bemerkung
Vin Frequenz	10 kHz	
Vin Amplitude	1 V	
Simulierte Perioden	3	

i Hinweis

Welche anderen Darstellungen des Verhältnisses zwischen Ausgang und Eingang würden sich eignen um Nachzuweisen, dass die Verzerrung akzeptabel ist?

1.1.4. Reale Spannungsquelle



Auf Dioden eingehen falls Ruhestrom egal. UBE-Vervielfacher

1.1.5. Stromversorgung

1.1.6. Reale Stromquelle

1.1.7. Praktische Herangehensweise

- welche Last muss versorgt werden.
- welche Lastströme sind gewünscht.
- Auswahl passender Transistoren in Bezug auf die maximale Werte.
- Definition der Qualitätsparameter, z.B. Differenz der ein und Ausgangsspannungen, Oberwellen Anteile, ...

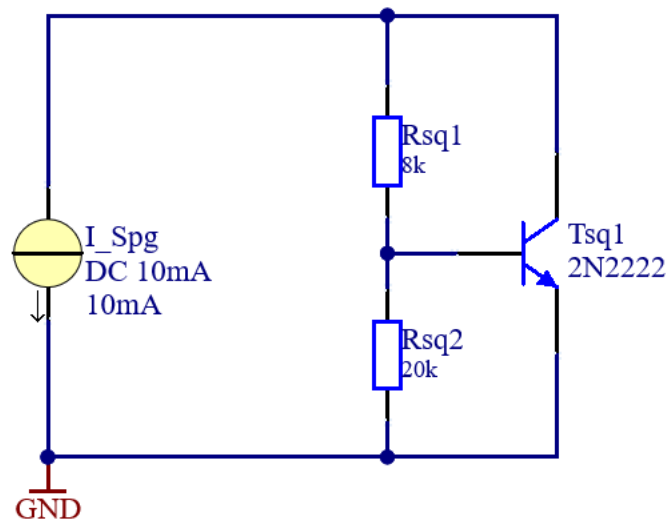


Abbildung 1.8.: Reale Vorspannungsquelle

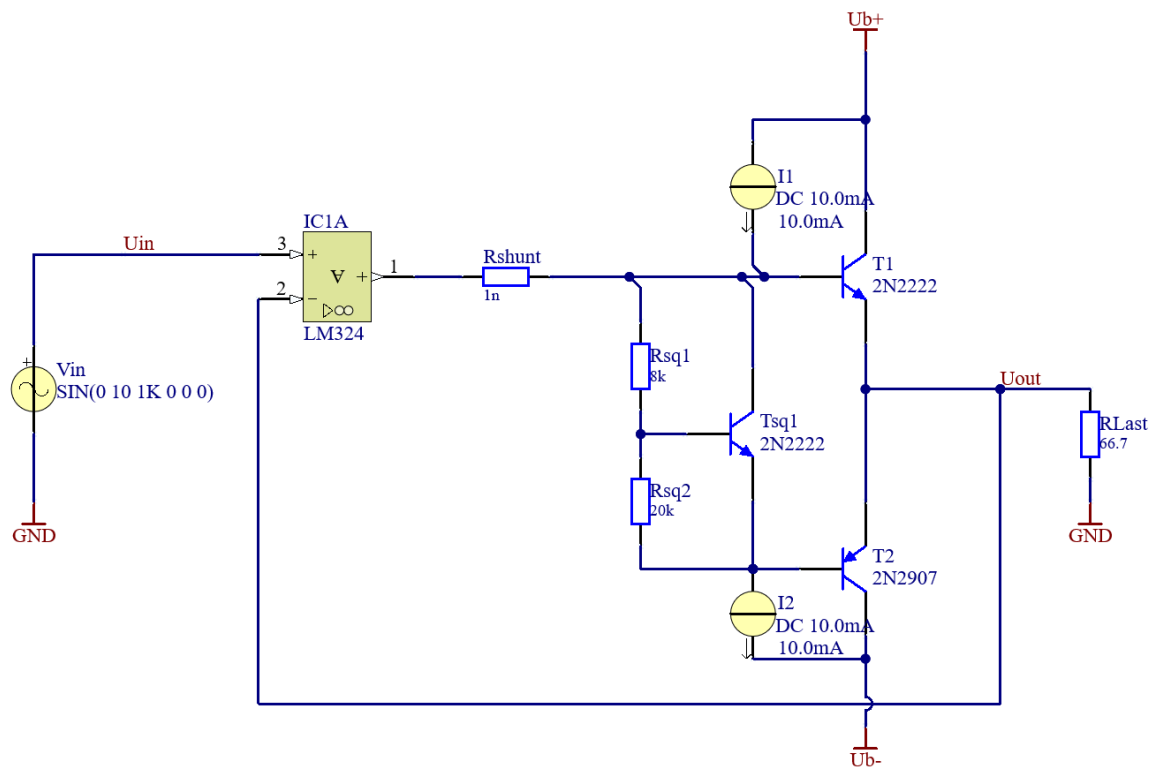


Abbildung 1.9.: Gegentaktendstufe mit Stromversorgung der Vorspannungsquelle

References

1. Biezl V Bipolartransistor Kennlinienfeld. <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7329334>. Accessed 19 Nov 2023